

FOTOVOLTAIK ELEMENTLARNING AVLODLARI

*Naimjonov Arslonbek Maxammadjon o`g`li Namangan davlat universiteti,
doktorant*

*Abdulkarimov Abdulaziz Abdubannayevich Namangan muhandislik
texnologiya instituti. f-m.f.n. PhD*

Namozaliyev Afzalbek G'ofurjon o'g'li Namangan davlat universiteti, magistr

Annotatsiya: Ushbu ishning maqsadi fotovoltaik elementlarning turli avlodlarini va ularning rivojlanish istiqbollarini muhokama qilish orqali quyosh elementlari haqidagi tushunchalarni boyitishdir. Ushbu ishda shuningdek turli quyosh elementlarining afzalliklari va kamchiliklari ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: fotovoltaik; quyosh elementlari; qayta tiklanadigan energiya; fotovoltaik elementlarni ishlab chiqarish texnologiyalari; samaradorlik; fotovoltaik avlodlar.

Abstract: The purpose of this work is to enrich the understanding of solar cells by discussing the different generations of photovoltaic cells and their development prospects. This work also presents the advantages and disadvantages of different solar cells.

Keywords: photovoltaic; solar elements; renewable energy; production technologies of photovoltaic elements; efficiency; photovoltaic generations.

Аннотация: Цель данной работы — обогатить понимание солнечных элементов путем обсуждения различных поколений фотоэлектрических элементов и перспектив их развития. В этой работе также представлены преимущества и недостатки различных солнечных элементов.

Ключевые слова: фотоэлектрические; солнечные элементы; возобновляемая энергия; технологии производства фотоэлектрических элементов; эффективность; фотоэлектрические поколения

Kirish. Hozirgi vaqtda quyosh energiyasi juda kam - 0,015% elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun, 0,3% isitish uchun va 11% biomassaning tabiiy fotosintezi uchun ishlatiladi. Aksincha, global energiyaga bo'lgan ehtiyojning taxminan 80-85 foizi qazib olinadigan yoqilg'i hisobiga qoplanadi. Qazib olinadigan yoqilg'ilarning qiyinligi shundaki, ularning resurslari cheklangan va CO₂ chiqindilari tufayli atrof-muhitga dushman. Masalan, yoqilgan har bir tonna ko'mir uchun atmosferaga bir tonna karbonat angidrid chiqariladi. Bu chiqarilgan karbonat angidrid atrof-muhit uchun zaharli bo'lib, global isish, issiqxona effekti, iqlim o'zgarishi va ozon qatlamining emirilishining asosiy sababidir [1].

Qayta tiklanuvchi energiya manbasi bo'lgan quyosh elementlari ham bir necha guruxlarga bo`linadi.

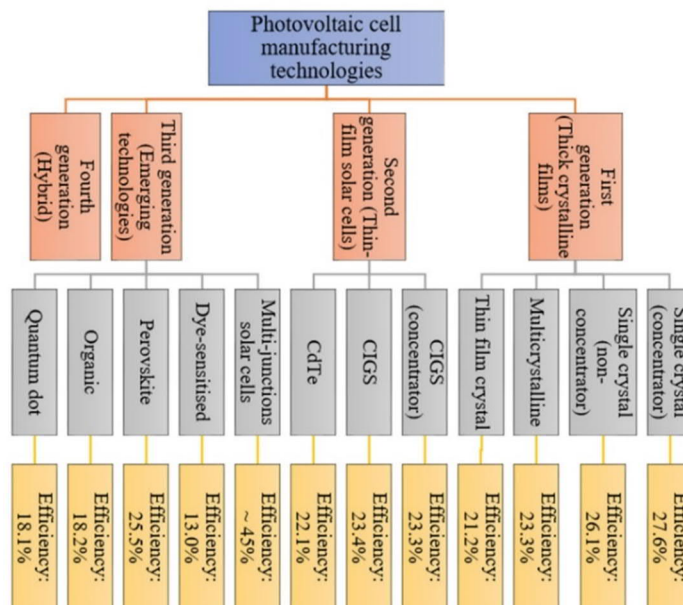
1. Birinchi avlod quyosh elementlariga monokristalli va polikristalli kremniy va galliy arsenidi (GaAs) asosidagi fotovoltaik texnologiyalar kiradi.

2. Ikkinchi avlod quyosh elementlariga takomillashgan birinchi avlod quyosh elementlari, "mikrokristalli kremniy (μ -Si) va amorf kremniy (a-Si) li quyosh elementlari, mis indiy galyum selenid (a-Si) dan tayyorlangan yupqa plyonkali fotovoltaik qurilmalar, kadmiy tellurid/kadmiy sulfidli quyosh elementlari kiradi.

3. Uchinchi avlod quyosh elementlari kimyoviy birikmalarga asoslangan fotovoltaik texnologiyalarni asoslanadi. Bundan tashqari, nanokristalli "plyonkalar", kvant nuqtali quyosh

elementlari, bo'yoqlarga sezgir bo'lgan quyosh batareyalari, organik polimerlar asosidagi quyosh batareyalari ham ushbu avlodga tegishli.

4. To'rtinchi avlod quyosh elementlari bu avlod yupqa plyonkali polimerlarning past moslashuvchanligi yoki arzonligi bilan bir qatorda "metall oksidi va metall nanozarralari kabi innovatsion noorganik nanostrukturalar yoki grafen, uglerod nanotubalari va grafen hosilalari kabi organik asosli nanomateriallar" ning chidamliligini o'z ichiga oladi [2].



2.2-jadval. Quyosh elementlarining turlari[3].

Birinchi avlod quyosh elementlari. Kremniyga asoslangan quyosh elementlari hozirda dunyodagi o'rnatilgan panellarning 80% dan ortig'ini tashkil qiladi va bozor ulushining 90%i ga ega. Nisbatan yuqori samaradorlik tufayli ular eng ko'p ishlatiladigan elementdir. Fotovoltaik elementlarning birinchi avlodi Si kremniydan tashkil topgan qalin kristalli qatlamlarga asoslangan materiallarni o'z ichiga oladi. Ushbu avlod mono-, poli- va ko'p kristalli kremniyga, shuningdek, yagona III-V o'tish (GaAs)ga asoslangan [1],[4].

Birinchi avlod quyosh elementlarining farqlari[1]:

- Monokristalli kremniyga asoslangan quyosh elementlari.
Samaradorlik: 15 ÷ 24%; Taqiqlangan zona: ~1,1 eV; Yaroqlilik muddati: 25 yil; Afzalliklari: Barqarorlik, yuqori sifatda ishlash, uzoq xizmat muddati; Kamchiliklari: yuqori ishlab chiqarish xarajatlari, haroratga sezgirliigi, abzorbsiya muammosi, material yemirilishi.
- Polikristalli kremniyga asoslangan quyosh elementlari.
Samaradorlik: 10 ÷ 18%; Taqiqlangan zona: ~1,7 eV; Yaroqlilik muddati: 14 yil; Afzalliklari: Ishlab chiqarish jarayoni oddiy, daromadli, kremniy chiqindilarini kamaytiradi, monokristal kremniy bilan solishtirganda yuqori abzorbsiya; Kamchiliklari: past samaradorlik, yuqori harorat sezgirliigi.
- GaAs ga asoslangan quyosh elementlari.
Samaradorlik: 28 ÷ 30%; Taqiqlangan zona: ~1,43 eV; Yaroqlilik muddati: 18 yil; Afzalliklari: Yuqori barqarorlik, past harorat sezgirliigi, m-si dan yaxshiroq abzorbsiya, yuqori samaradorlik; Kamchiligi: juda qimmat [1].

Ikkinchi avlod quyosh elementlari. CdTe, galliy selenid va mis yoki amorf kremniyga asoslangan yupqa plyonkali fotovoltaiik elementlar kristalli kremniy quyosh elementlariga arzonroq o`rinbosar sifatida ishlab chiqarilgan. Ularni egiluvchan jihozlarga o`rnatish uchun ideal bo`lgan mexanik xususiyatlar bor, ammo bu samaradorlikni pasaytirish xavfini orttiradi. Quyosh elementlarining birinchi avlodi mikroelektronikaning timsoli bo`lgan bo`lsa, yupqa plyonkalar evolyutsiyasi o`stirishning yangi usullarini talab qildi va sektorni boshqa sohalarga, masalan, elektrokimyoga ham ochdi[5].

Ikkinchi avlod quyosh elementlarining farqlari:

Amorf kremniyga asoslangan quyosh elementlari (a-si).

- Samaradorlik: $5 \div 12\%$; Taqiqlangan zona: $\sim 1,7$ eV; Yaroqlilik muddati: 15 yil; Afzalliklari: Arzonroq, tabiatda ko`p miqdorda mavjud, toksik bo`lmagan, yuqori abzorbsiya koeffitsienti; Kamchiliklari: past samaradorlik, dopant materiallarni tanlashda qiyinchilik, zaryad tashuvchilarining qisqa yashash vaqti.

Kadiy tellurid/kadiy sulfid (CdTe/CdS) asosidagi quyosh elementlari.

- Samaradorlik: $15 \div 16\%$; Taqiqlangan zona: $\sim 1,45$ eV; Yaroqlilik muddati: 20 yil; Afzalliklari: Yuqori abzorbsiya darajasi, ishlab chiqarish uchun kamroq material talab qilinadi; Kamchiliklari: past samaradorlik, Cd juda zaharli, Te cheklangan, haroratga ko`proq sezgir.

Mis indiy galliy selenid (CIGS) asosidagi quyosh elementlari.

- Samaradorlik: 20% ; Taqiqlangan zona: $\sim 1,7$ eV; Yaroqlilik muddati: 12 yil; Afzalliklari: Ishlab chiqarish uchun kamroq material talab qilinadi; Kamchiliklari: juda yuqori narx, barqaror emas, haroratga nisbatan sezgir, juda ishonchsiz [6].

Uchinchi avlod quyosh elementlari. Quyosh elementlarining uchinchi avlodi tandem, perovskit, bo`yoqqa sezgir, organik va yangi paydo bo`layotgan quyosh element turlarini o`z ichiga oladi. Bu avlod quyosh elementi arzon past samarali quyosh elementlaridan tortib (bo`yoqqa sezgir, organik quyosh elementlari) qimmat va yuqori samarali elementlargacha (III-V ko`p o`tishli elementlar) bo`lgan turli hil bo`lishi mumkin. Uchinchi avlod fotovoltaiik elementlarning ba`zan bozordagi ulushi kichikligi sababli "rivojlanayotgan soha" deb ataladi, garchi ularning ba`zilari 25 yildan ortiq vaqt davomida o`rganilgan bo`lsa ham [7]. FV elementlarning samaradorligini oshirishning hozirgi usullaridan biri yarimo`tkazgichning taqiq zonasida qo`shimcha energiya sathlarini joriy etish va ishlab chiqarish jarayonida ion implantatsiyasidan foydalanishni ko`paytirishdir [9]. Bizga ma`lum bo`lgan va endigina rivojlanayotgan uchinchi avlod quyosh elementlarining turlari quyidagilar[8] :

- 1.Organik quyosh elementlari.
- 2.Perovskit quyosh elementlari.
- 3.Yuqori sezgir bo`yoqli quyosh elementlari.
- 4.Kvant nuqtali quyosh elementlari.
- 5.Ko`p qatlamli tandem quyosh elementlari[8].

Uchinchi avlod quyosh elementlarining farqlari:

Bo`yoqqa sezgir fotovoltaiik moddaga asoslangan quyosh elementlari.

- Samaradorlik: $5 \div 20\%$; Afzalliklari: arzonroq xarajat, past yorug'lik va kengroq burchakda ishlash, past ichki haroratda ishlash, mustahkamlik va uzoq muddat xizmat ko'rsatish; Kamchiliklari: harorat barqarorlikdagi muammolar, zaharli, uchuvchan moddalardan tayyorlanishi.

Kvant nuqtali quyosh elementlari.

- Samaradorlik: $11 \div 17\%$; Afzalliklari: Kam ishlab chiqarish xarajati, kam energiya iste'moli; Kamchiliklari: Tabiatda yuqori toksiklik, degradatsiya.

Organik va polimerik moddalarga asoslangan quyosh elementlari.

- Samaradorlik: $9 \div 11\%$; Afzalliklari: past tannarxi, yengilroq, egiluvchanlik, termal barqarorlik; Kamchiliklari: past samaradorlik.

Perovskit quyosh elementlari

- Samaradorlik: 21% ; Afzalliklari: Arzon va soddalashgan tuzilish, yengil vazn, moslashuvchanlik, yuqori samaradorlik, past ishlab chiqarish narxi; Kamchiliklari: barqaror emas.

Ko'p qatlamli tandem quyosh elementlari.

Samaradorlik: 36% va undan yuqori; Afzalliklari: Yuqori samaradorlik; Kamchiliklari: murakkab, qimmat [1]

Xulosa

Quyosh energiyasi elektr energiyasining eng talabchan qayta tiklanadigan manbalaridan biridir. Fotovoltaik texnologiyadan foydalangan holda elektr energiyasi ishlab chiqarish nafaqat energiyaga bo'lgan talabni qondirishga yordam beradi, balki qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish orqali global iqlim o'zgarishini yumshatishga ham hissa qo'shadi. Innovatsion yangi avlod quyosh batareyalarining raqobatbardoshlik darajasi tadqiqotchilar va olimlarning yangi materiallar, xususan, nanomateriallar va nanotexnologiyalarni ishlab chiqish bilan bog'liq sa'y-harakatlari tufayli ortib bormoqda.

Birinchi avlod quyosh elementlari an'anaviy va kremniy gofretlarga asoslangan. Quyosh batareyalarining ikkinchi avlodi yupqa plyonkali texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Quyosh elementlarining uchinchi avlodi yangi texnologiyalarni o'z ichiga oladi, jumladan, organik materiallardan tayyorlangan quyosh elementlari, perovskitlardan yasalgan elementlar, bo'yoq bilan sezgirlangan elementlar, kvant nuqta elementlari yoki ko'p ulanishli elementlar. Texnologiyaning rivojlanishi bilan to'rtinchi avlod grafenga asoslangan quyosh batareyalarida oldingi avlodlarning kamchiliklari bartaraf etildi. Fotovoltaiklarning mashhurligi uchta jihatga bog'liq - narx, xom ashyo mavjudligi va samaradorlik. Uchinchi avlod quyosh elementlari fotovoltaiklarning eng yangi va istiqbolli texnologiyasidir. Bular bo'yicha tadqiqotlar hali ham davom etmoqda. Ushbu ko'rib chiqishda quyosh batareyalarining yangi avlodiga alohida e'tibor beriladi: ko'p o'tishli elementlar va qo'shimcha oraliq zo'nali fotovoltaik elementlar.

Adabiyotlar

[1] Singh, B.P.; Goyal, S.K.; Kumar, P. Solar PV cell materials and technologies: Analyzing the recent developments. Mater. Today Proc. 2021, 43, 2843-2849.

[2] Luque, A.; Hegedus, S. (Eds.) Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, 2nd ed.; John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2011; pp. 4-36. [CrossRef]

[3] Marques Lameirinhas, R.A.; Torres, J.P.N.; de Melo Cunha, J.P. A Photovoltaic Technology Review: History, Fundamentals and Applications. *Energies* 2022, 15, 1823.

[4] Marques Lameirinhas, R.A.; Torres, J.P.N.; de Melo Cunha, J.P. A Photovoltaic Technology Review: History, Fundamentals and Applications. *Energies* 2022, 15, 1823.

[5] Kuczyńska-Łażewska, A.; Klugmann-Radziemska, E.; Witkowska, A. Recovery of Valuable Materials and Methods for Their Management When Recycling Thin-Film CdTe Photovoltaic Modules. *Materials* 2021, 14, 7836.

[6] Muhammad, J.Y.U.; Waziri, A.B.; Shitu, A.M.; Ahmad, U.M.; Muhammad, M.H.; Alhaji, Y.; Olaniyi, A.T.; Bala, A.A. Recent progressive status of materials for solar photovoltaic cell: A comprehensive review. *Sci. J. Energy Eng.* 2019, 7, 77-89.

[7] Hayat, M.B.; Ali, D.; Monyake, K.C.; Alagha, L.; Ahmed, N. Solar energy-A look into power generation, challenges, and a solar-powered future. *Int. J. Energy Res.* 2019, 43, 1049-1067.

[8] Peumans, P.; Yakimov, A.; Forrest, S.R. Small molecular weight organic thin-film photodetectors and solar cells. *J. Appl. Phys.* 2003, 93, 3693-3723.

[9] Wegierek, P.; Billewicz, P. Research on Mechanisms of Electric Conduction in the p-Type Silicon Implanted with Ne⁺ Ions. *Acta Phys. Pol. A* 2013, 123, 948-951.